

2SC892

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

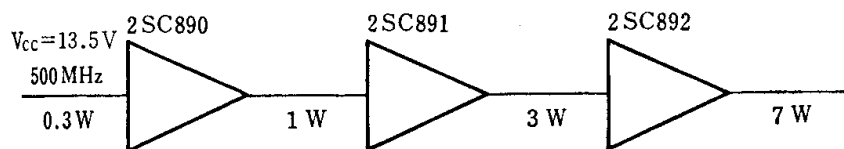
高周波電力増幅用 / High Frequency Power Amplifier

通信工業用 / Industrial Use

特徴 / FEATURES

- ・400MHz 帯で高出力が得られます。 $P_o = 8.0W$ TYP.
($V_{CC} = 13.5V$, $P_i = 3.0W$, $f = 500MHz$)
- ・低い電源電圧でも動作するため、車載無線機用として最適です。
実用電源電圧 9~18V
- ・フラットパッケージであるため、プリント配線とのマッチングがよい。
- ・エミッタ電極がスタッドに接続されているため動作が安定です。
- ・スタッド構造のため放熱設計が容易です。
- ・ $P_o = 8.0W$ TYP. @ $V_{CC} = 13.5V$, $P_i = 3.0W$, $f = 500MHz$.
- ・Suitable for mobile radio equipment operating at 9 to 18 volts.

Typical Lineup



絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	1.2	A
コレクタ電流 (ピーク)	$I_{C(peak)}$	4.0	A
全損失	$P_T(T_C = 25^\circ C)$	17.7	W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	8.5	$^\circ C/W$
ジャンクション温度	T_j	175	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-40~+175	$^\circ C$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 20V$, $I_E = 0$			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 10V$, $I_C = 1.0A^*$	15			
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10V$, $I_E = -300mA$	400			MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V$, $I_E = 0$, $f = 1.0MHz$			26	pF
出力電力	P_o	$V_{CC} = 13.5V$, $P_i = 3.0W$, $f = 500MHz$ See test circuit	7.0	8.0		W

* パルス測定 $PW \leq 350\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)

